

**ALLEGATO C:**

**RIEPILOGO CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI**

**ATOMIC LAYER DEPOSITION SYSTEM (ALD)**

Nel presente documento – da caricare a sistema come “Allegato tecnico - devono essere riportate, tabulate, le eventuali caratteristiche tecniche e funzionali migliorative offerte per il sistema Atomic Layer Deposition (ALD).

Al fine di consentire alla Commissione di gara la valutazione dell’offerta tecnica, il Concorrente dovrà compilare le sottostanti tabelle, mediante indicazione dei valori/parametri offerti e il riferimento al relativo paragrafo della relazione tecnica. Nella colonna “Valore/parametro offerto” devono essere indicati precisamente i parametri dell’attrezzatura proposta; non sono ammessi range o diciture generiche.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **n°** | **Strumento o tipologia di processo** | **Elemento** | **Valore/parametro offerto** | **Riferimento nella relazione tecnica (pagina, paragrafo, eventuale codice)** |
| 1.1 | **Requisiti migliorativi funzionali** | Upgrade per depositare i materiali aggiuntivi AlN, SiN, HfO2, incluso le linee di precursori e di gas richiesti, e incluso le rispettive ricette di deposizione. |  |  |
| 1.2 | Temperatura massima di deposizione > 400C |  |  |
| 1.3 | Presenza di sistema di metrologia direttamente in situ: ellissometro o analisi dei gas residui. |  |  |
| 1.4 | Presenza di linea e generatore di Ozono |  |  |
| 1.5 | Possibilità di eseguire la deposizione su parti di wafer di silicio (caricabili manualmente in camera). |  |  |
| 1.6 | Caricamento automatico cassette to cassette di wafers da 8 pollici in aggiunta a quelli da 6 pollici. |  |  |
| 1.7 | Anno aggiuntivo di garanzia |  |  |
| 2.1 | Processo #1 – TiN layer deposition | Deposition rate ≥0.11 nm/min |  |  |
| 2.2 | Processo #1 – TiN layer deposition | WIWNU\*\* < ±6% |  |  |
| 2.3 | Processo #1 – TiN layer deposition | Conformality (Thickness on the wall at the bottom of the trench/Thickness on the wafer surface)  > 0.6 |  |  |
| 2.4 | Processo 2: SiO2 deposition | WIWNU\*\* < 3.5 |  |  |
| 2.5 | Processo 3: Al2O3 deposition | WIWNU\*\* < 3.5 |  |  |

*\* WIWNU = Within Wafer Not Uniformity calcolata come (Max-Min)/(2\*Average) su tutta la superficie della fetta con esclusione di 5mm dal bordo*